

# 第二章 基本放大电路



- § 2.2 基本共射放大电路的工作原理
- § 2.3 放大电路的分析方法
- § 2.4 静态工作点的稳定
- § 2.5 晶体管放大电路的三种接法
- § 2.6 场效应管及其基本放大电路





#### ▶ 晶体管最大的作用是放大

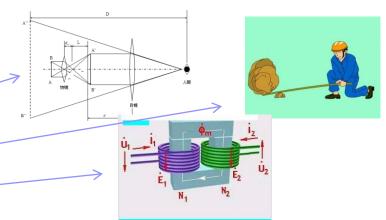
### > 为什么需要放大?

●应用需求广泛:

□光学放大:投影仪、相机...

□力学放大: 杠杆原理...

□电学放大:变压器...



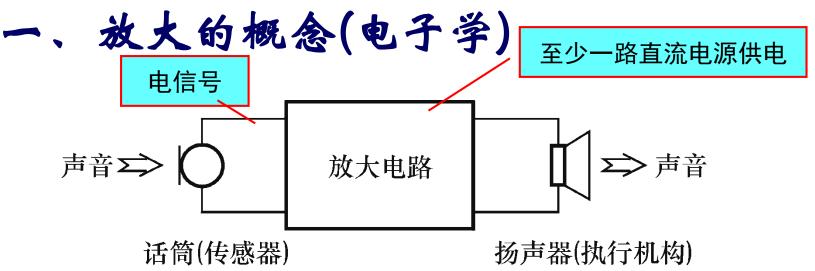
#### > 放大和电子技术的关系?

- ●BELL电话公司的困境:
- □ 1894&1895年,贝尔电话的专利在美国和加拿大过期,此后10年内,美国出现6000多家电话公司,面临竞争,贝尔开始大肆收购电话公司
- □ 联邦政府基于谢尔曼法案 (1890年通过的反托拉斯法案) 调查AT&T, 1913年, Kingsbury申明的发表, AT &T (BELL) 转为长途电话服务商
- □长途电话业务,需要高效、可靠的中继器放大声音信号
  - ✓ 放大的需求催生了电子技术(晶体管的发明)和电子产业(硅谷)
  - ✓ 对电信号的放大是模拟电子技术的最广泛和最基础的应用



- 一. 放大的概念(电子学)
- 二. 放大电路的性能指标





□ 放大的对象: 变化量

□ 放大的特征: 功率放大

□ 放大的本质: 能量的控制和转换

□ 放大的基本要求:不失真——放大的前提

判断电路能否放大的基

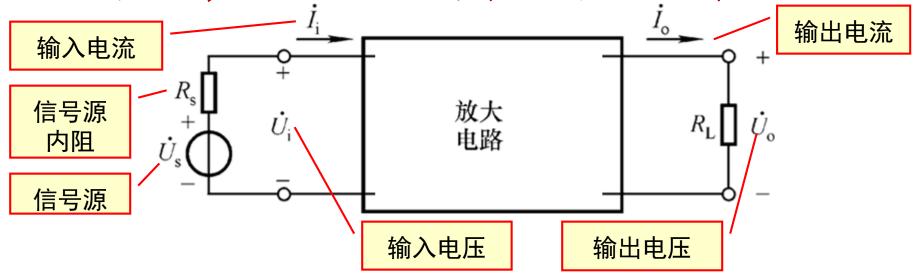
本出发点



### 二、性能指标(动态参数)

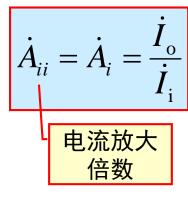
常以正弦波作为测试信号!

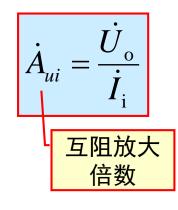
>对信号而言, 任何放大电路均有输入和输出两个端口

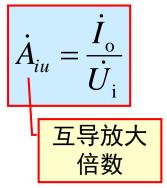


▶ 1. 放大倍数: 输出量与输入量之比

$$\dot{A}_{uu} = \dot{A}_{u} = rac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}}$$
电压放大倍数,是最常被研究和测试的参数



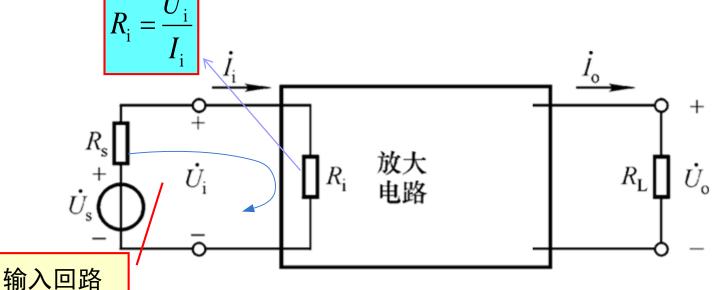






> 2. 输入电阻: 从放大电路输入端看进去的等效电阻

即,输入电压与输入电流有效值之比



● R<sub>i</sub>: 衡量放大电路向信号源索取电流的大小

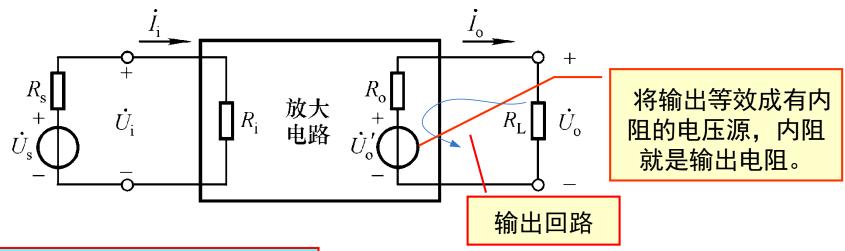


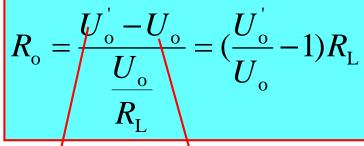
R;大些好还是小些好?

若信号源为电压源, $R_i$ 大些好还是小些好?若信号源为电流源呢?



> 3. 输出电阻: 从放大电路输出端看进去的等效电阻





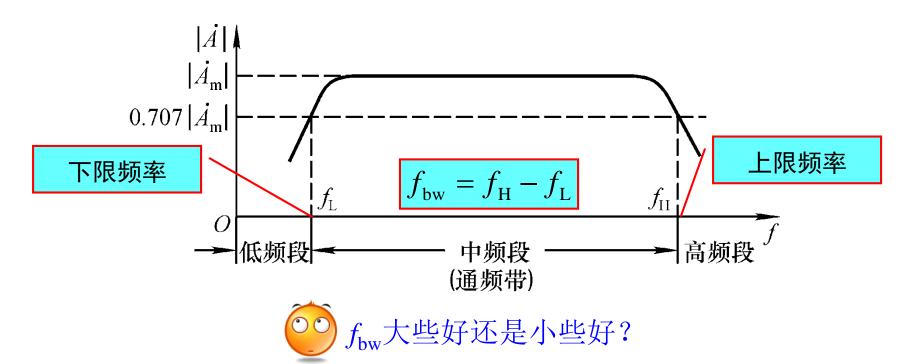
空载时输出电压 有效值 带R<sup>L</sup>时的输出 电压有效值 •  $R_O$ : 衡量放大电路输出的带负载能力(负载接入对输出的影响)



 $R_{O}$ 大些好还是小些好?



- > 4. 通频带:上限截止频率与下限截止频率之差
  - □衡量放大电路对不同频率信号的放大能力
  - □ 放大电路中的电容、电感及半导体器件PN结电容影响电信号的传递速度,当输入信号频率较低和较高时,放大电路电压放大倍数数值下降,输出产生相移





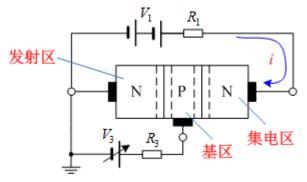
- $\triangleright$  5. 最大不失真输出电压 $U_{\mathrm{om}}$ : 输出基本不失真情况下的最大 $U_{\mathrm{O}}$ , 一般用有效值表示
- ▶ 6.非线性失真系数D:输出波形中谐波成分总量与基波分量之比
- ▶ 7.最大输出功率Pom和效率η:
  - □ Pom: 输出基本不失真情况下负载上能获得的最大功率
  - $\square$   $\eta$ : 最大輸出功率与电源消耗功率之比  $\eta = P_{om}/P_V$



- 一. 电路的组成及各元件的作用
- 二. 设置静态工作点的必要性
- 三. 波形分析
- 四. 放大电路的组成原则



## 一、电路的组成及各元件的作用

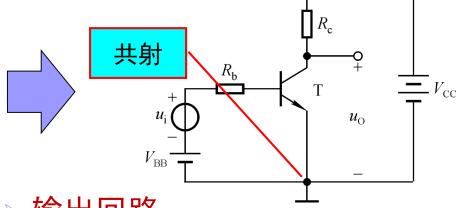


### > 输入回路

□ V<sub>BB</sub>: 保证发射结正偏

□ R<sub>b</sub>: 基极偏置电阻,作用?

 $\square u_i$ : 信号源,被放大的对象



#### > 输出回路

□ V<sub>CC</sub>: 保证集电结反偏

□ R<sub>c</sub>: 集电极负载电阻

▶ 静态: u<sub>i</sub>0时的电路工作状态(直流工作状态)

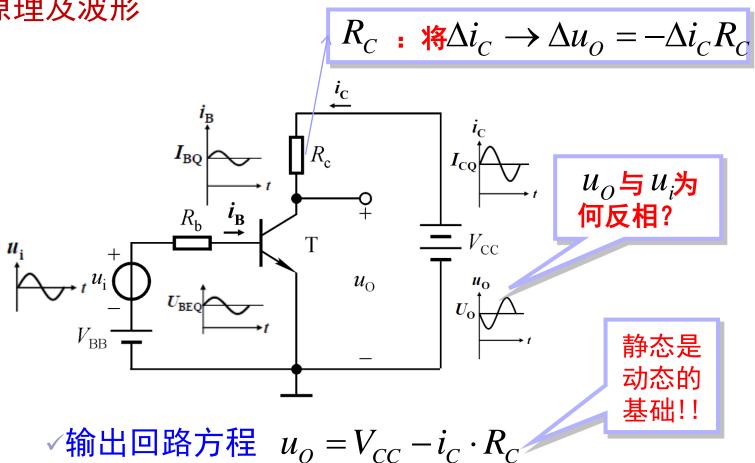
ightharpoonup 静态工作点: 静态时晶体管各极的直流电流和电压,简称Q点  $ightharpoonup I_{BQ}, I_{CQ}(I_{EQ}), U_{BEQ}, U_{CEQ}$ 

 $\rightarrow$  动态:  $u\neq0$ 时的,电路中各处电压、电流的交变状态

$$\Delta u_{\mathrm{I}} \rightarrow \Delta i_{\mathrm{B}} \rightarrow \Delta i_{\mathrm{C}} \rightarrow \Delta u_{R_{\mathrm{c}}} \rightarrow \Delta u_{\mathrm{CE}} (u_{\mathrm{o}})$$



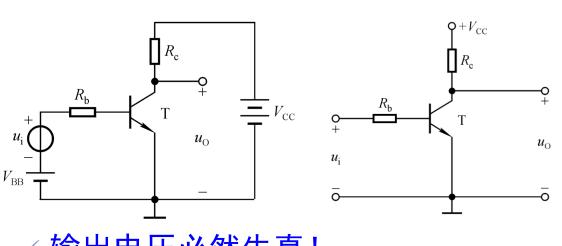


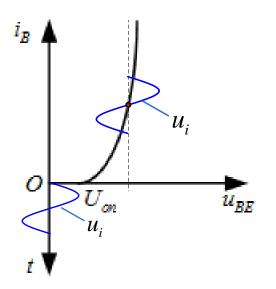




### 二、设置静态工作点的必要性

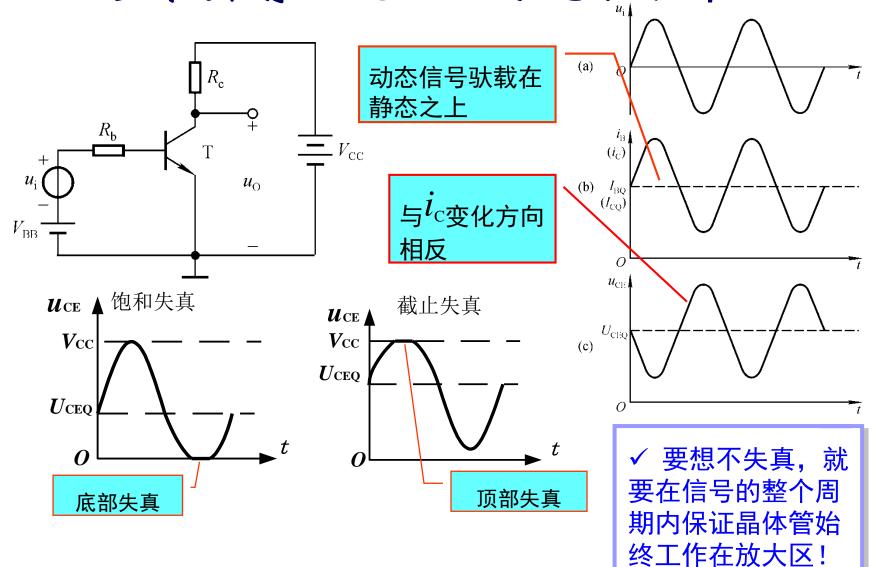
▶ 放大的对象是什么?基本要求是什么?





- √ 输出电压必然失真!
  - □ 只有设置合适的Q点,使晶体管在信号整个周期内全部处于 放大状态,波形才不会失真,Q点几乎影响着所有的动态参数!

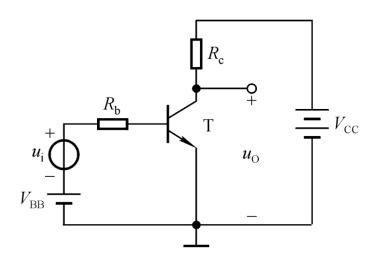
## 基本共射放大电路的波形分析





### 四、放大电路的组成原则

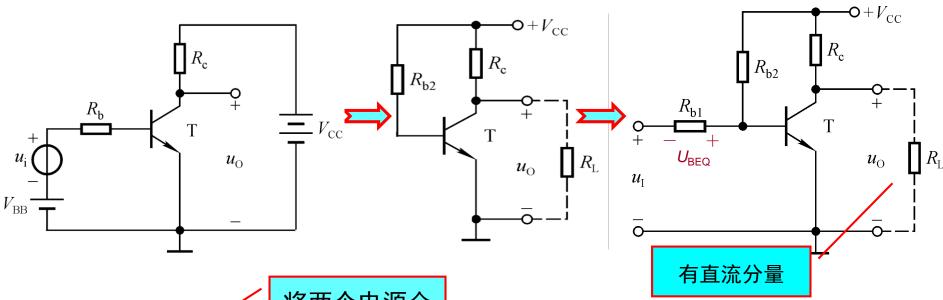
- ▶ 静态工作点: 合适的直流电源、合适的电路参数
- → 动态信号: 能够作用于晶体管的输入回路, 在负载上能够获得放大的动态信号
- ➢ <u>实用放大电路:</u> 共地,直流电源种类尽可能少,负载上无直流分量





### ▶ 如何组成实用放大电路?

□直接耦合放大电路



✓ 问题:

将两个电源合 二为一

- 1. 两种电源
- 2. 信号源与放大电路不"共地"

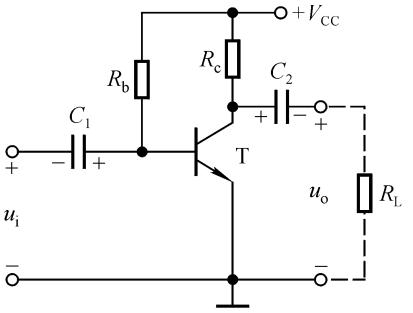
共地,且要使信号驮 载在静态之上

- $\triangleright$  静态时, $U_{\mathrm{BEQ}}=U_{R_{\mathrm{hl}}}$
- ho 动态时, $V_{\rm CC}$  和 $u_{\rm I}$  同时作用于晶体管的输入回路。动态信号驮载在静态之上



### ▶ 如何组成实用放大电路?

□ 阻容耦合放大电路



### ✓ C<sub>1</sub>,C<sub>2</sub>为耦合电容

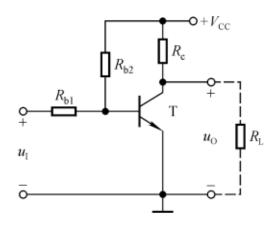
● 耦合电容容量应足够大,对于交流信号可近似为短路,作用 "隔 离直流、通过交流"

- 静态时, $U_{\text{C1}} = U_{\text{BEQ}}, u_{\text{C2}} = U_{\text{CEQ}}$
- 动态时, $u_{BE}=u_{I}+U_{BEQ}$ ,信号驮载在静态之上,负载上只有交流信号

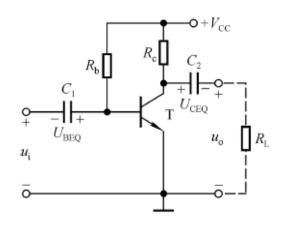


### 两种实用放大电路的比较

### □直接耦合共射放大电路



### □阻容耦合共射放大电路



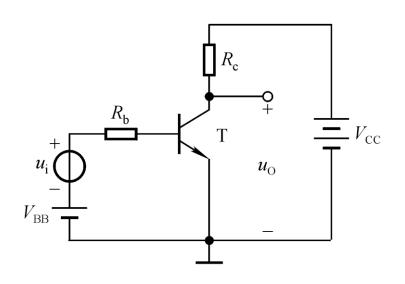
	直接耦合		阻容耦合
共同点	✓ 信号源与放大电路共地 ✓ 单电源供电		
不同点	✓ 电阻R <sub>b1</sub> 上有交流损耗 ✓ 负载上有直流信号 ✓ 低频特性好 ✓ 易于集成	✓ 1 ✓ 1	电容C <sub>1</sub> ,C <sub>2</sub> 上交流损耗很小 负载上只有交流信号 低频特性差 不易于集成

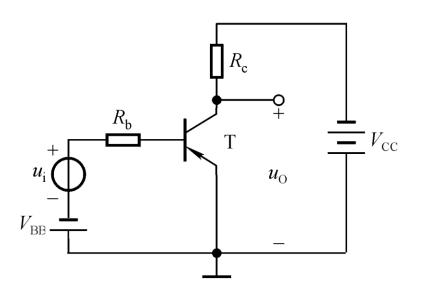


### > 讨论

照葫芦画瓢!

□1. 用PNP型晶体管组成一个共射放大电路



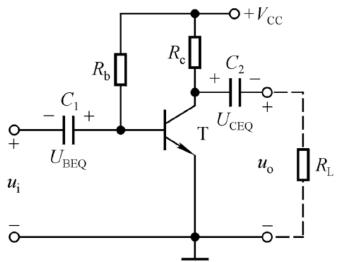




- 一. 放大电路的直流通路和交流通路
- 二. 图解法
- 三. 等效电路法

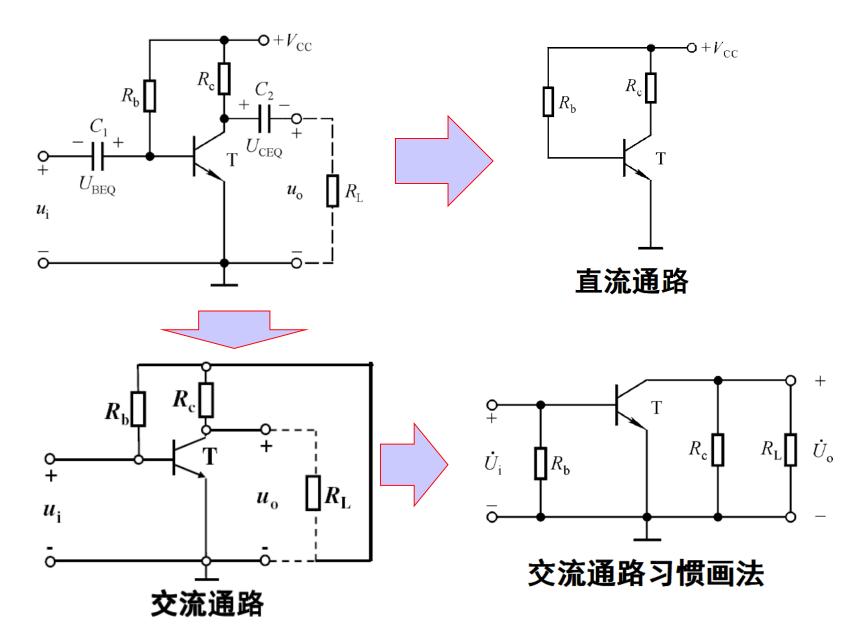


### 一、放大电路的直流通路和交流通路



- > 多电源电路如何进行定量分析?
  - □叠加原理: 适用线性电路
- ▶ 如何确保叠加原理适用?
  - □被放大信号:交流小信号
- > 如何应用叠加原理?
  - □ 电路分解为直流通路+交流通路
- > 直流通路: 直流电源作用下直流电流流经的通路
  - $\square$  ① $U_s$ 短路,保留 $R_s$ ; ②电容开路; ③电感短路
- > 交流通路: 输入信号作用下交流信号流经的通路
  - □① V<sub>CC</sub>短路,内阻为0;②电容短路







先静态, 后动态!

- >交、直流通路的作用?
  - 1、定性判断放大电路是否正常工作

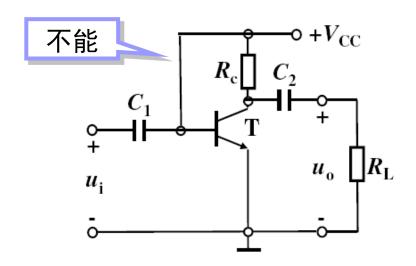
从直流通路分析

- ✓ 静态时晶体管工作在放大区、有合适的Q点
- ✓ 保证交流信号的有效传输

从交流通路分析

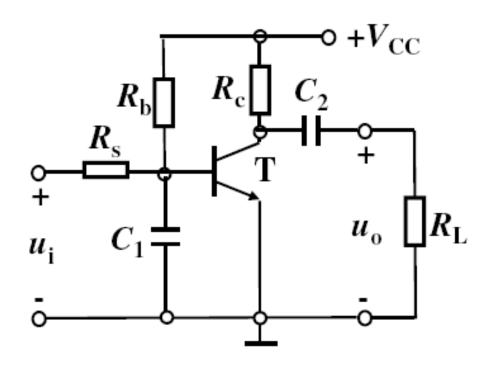
#### □ 讨论:

√以下电路能否正常放大输入信号?若不能,如何改正电路?



### 以下电路能否正常放大输入信号?

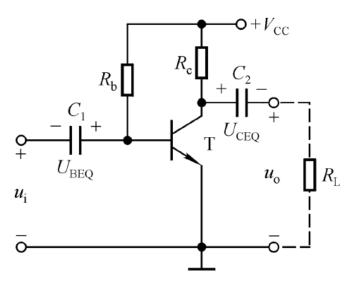
- A 不能
- B 能
- 无法判断

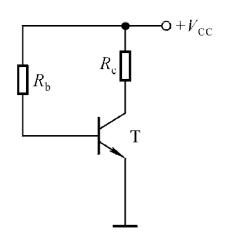




#### > 交、直流通路的作用?

- 2、定量估算放大电路的静动态参数
  - ✓ 直流通路: 定量估算静态工作点





$$I_{\text{BQ}} = \frac{V_{\text{CC}} - U_{\text{BEQ}}}{R_{\text{b}}}$$

$$I_{\text{CQ}} = \beta I_{\text{BQ}}$$

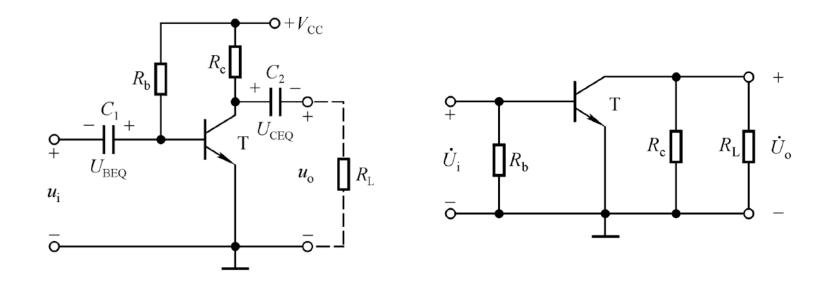
$$U_{\text{CEQ}} = V_{\text{CC}} - I_{\text{CQ}} R_{\text{c}}$$

 $V_{\rm CC}$ 越大, $U_{\rm BEQ}$ 取不同的值所引起的 $I_{\rm BO}$ 的误差越小

 $\checkmark$  列晶体管输入、输出回路方程,将 $U_{BEQ}$ 作为已知条件,令 $I_{CQ}$ = $\beta I_{BQ}$ ,可估算出静态工作点



- > 交、直流通路的作用?
  - ✓ 交流通路: 定量分析或估算动态性能



- 如何估算动态性能?
  - ✓ 图解法
  - ✓等效电路法



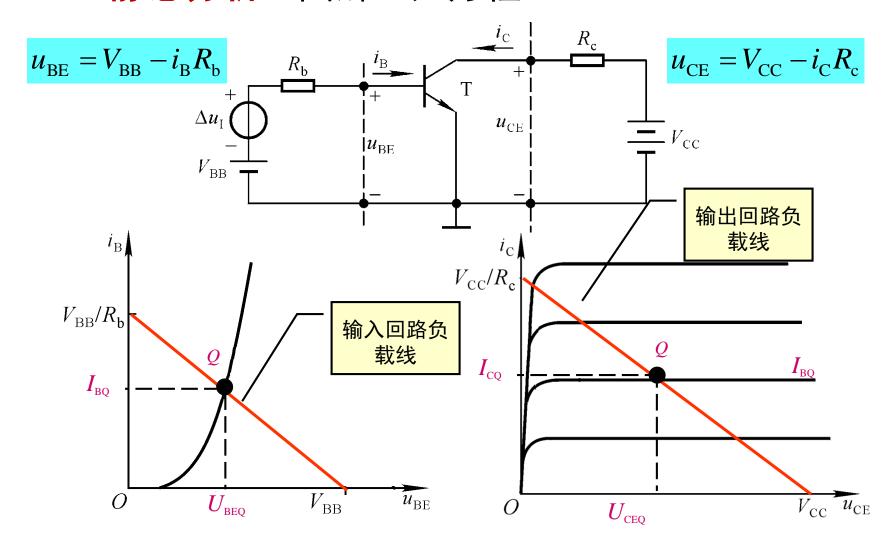
### 二、图解法

- ▶ 已知晶体管的输入、输出特性以及电路中其它元器件参数, 利用作图的方法结合交、直流通路来分析放大电路
  - □动态性能分析
    - ✓分析电压放大倍数A<sub>11</sub>、失真情况
    - $\checkmark$ 分析最大不失真输出电压 $U_{om}$
  - □静态性能分析
    - √分析Q点



### 应实测特性曲线!!!

### ▶ 1. **静态分析**: 图解二元方程



#### 2.3 放大电路分析方法

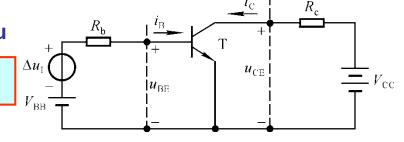
 $I_{\rm B} = I_{\rm BO} + \Delta i_{\rm B}$ 

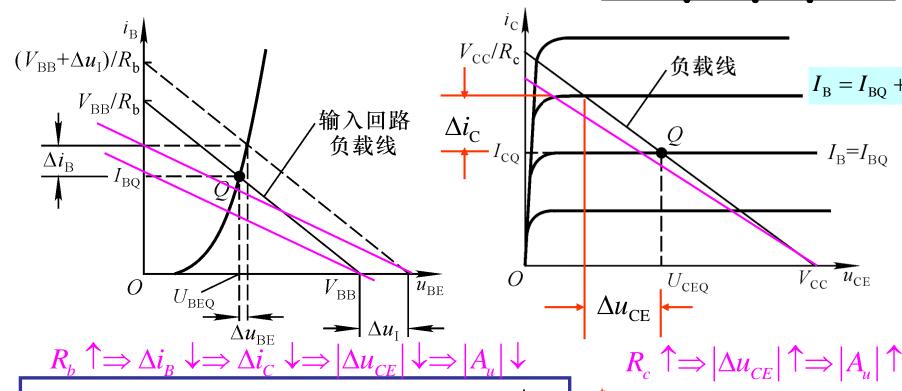
 $I_{\mathrm{B}} = I_{\mathrm{BQ}}$ 

### ▶ 2. 动态分析: 电压放大倍数A<sub>u</sub>

$$u_{\mathrm{BE}} = V_{\mathrm{BB}} + \Delta u_{\mathrm{I}} - i_{\mathrm{B}} R_{\mathrm{b}}$$

斜率不变





给定
$$\Delta u_{\rm I} \to \Delta i_{\rm B} \to \Delta i_{\rm C} \to \Delta u_{\rm CE}(\Delta u_{\rm O}) \to A_u = \frac{\Delta u_{\rm O}}{\Delta u_{\rm I}}$$

 $\Delta u_0$ 与 $\Delta u_1$ 反相, $A_\mu$ 符号为"一"。



 $✓ R_b$ 增大, $A_{\parallel}$ 变化么?

✓ R。增大呢?

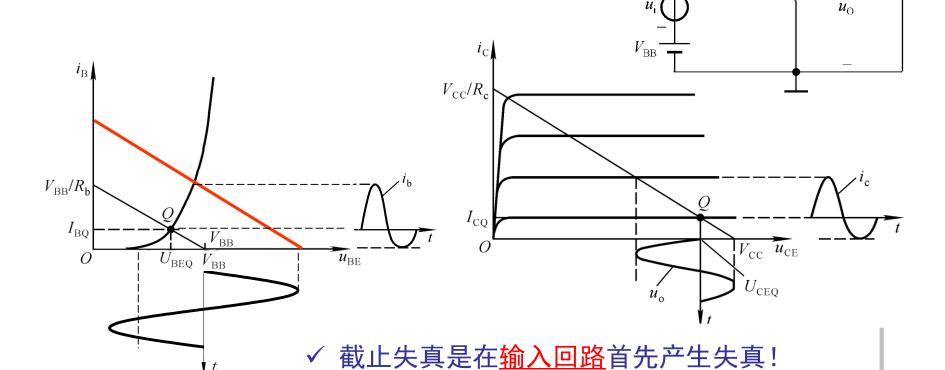
#### 2.3 放大电路分析方法

 $R_{\rm c}$ 

 $\underline{\hspace{1cm}}V_{\mathrm{cc}}$ 

 $R_{\rm b}$ 

▶ 2. 动态分析: 失真(截止失真)





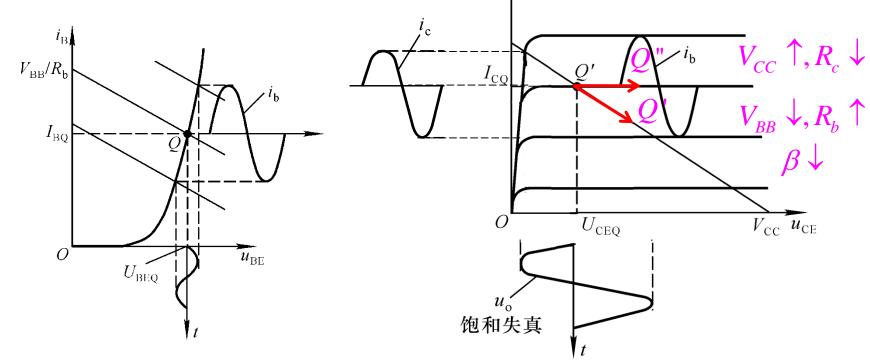
✓ 消除截止失真的办法?  $V_{\scriptscriptstyle BB}$  ↑

✓ 最大截止不失真输出电压峰值为  $(V_{CC} - U_{CEO})$ 

- ✓ 减小R。呢?
- ✓ 减小R<sub>b</sub>能消除截止失真吗?



### > **2. 动态分析: 失真(**饱和失真) ick



- ✓ 饱和失真是在<u>输出回路</u>首先产生失真!
- ✓ 最大饱和不失真输出电压峰值为  $(U_{CFO} U_{CES})$
- ✓ 放大电路的最大不失真输出电压有效值:

$$U_{om} = \min\left\{ \left( V_{CC} - U_{CEQ} \right), \left( U_{CEQ} - U_{CES} \right) \right\} / \sqrt{2}$$



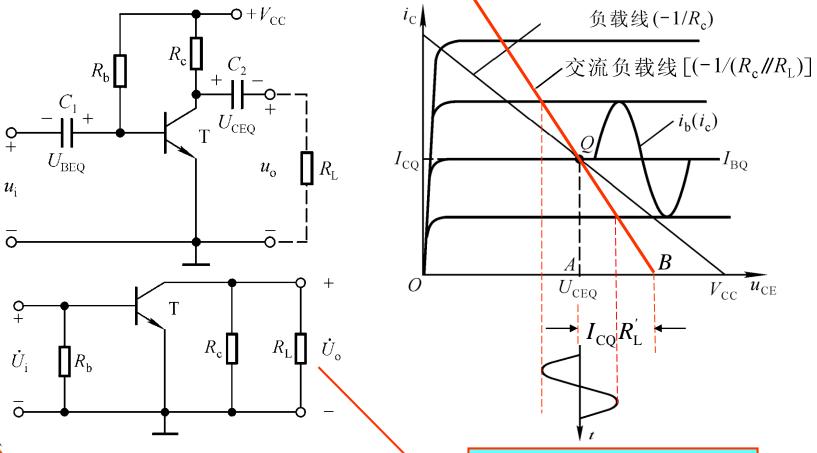
✓ 消除方法?



### > 直流负载线和交流负载线

□直接耦合电路: 重合

□阻容耦合电路:不重合





 $U_{\text{om}}$ =? Q点在什么位置 $U_{\text{om}}$ 最大?

交流负载线应过Q点,且 斜率决定于  $(R_c // R_L)$ 



### > 图解法总结

### □优点

✓ 能比较直观、全面地反映晶体管的工作情况

### □缺点

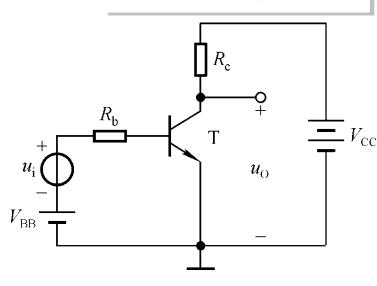
- ✓ 不方便, 晶体管特性曲线不易得到
- ✓ 输入信号较小或频率较高时不准确
- ✓ 只适用于中低频大幅值信号



### 三、等效电路法

- > 半导体器件的非线性特性使放大电路的分析复杂化
- > 利用线性元件建立模型,描述一定条件下的非线性特性

#### √有哪些等效模型?



- □ *u<sub>i</sub>*=0时,仅有直流电源作用,即静态 **直流等效模型**
- □ 在静态的基础上加低频小信号 —

### ᆕ<sup>Ⅴcc</sup> 交流等效模型

□ 在静态的基础上加高频小信号, 考虑结电容的影响—<mark>高频等效模型</mark>

#### √如何构造等效模型?

从外部特性

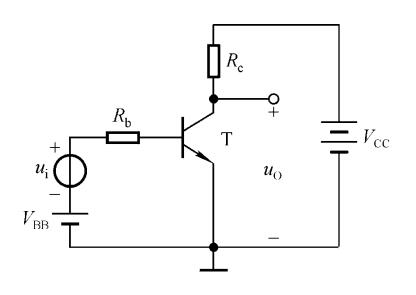
从内部结构

简单,适于近似分析

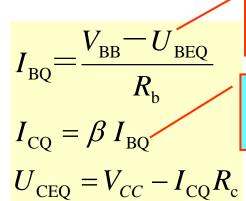
复杂,适于EDA



### > 1. 直流模型: 适于Q点的分析

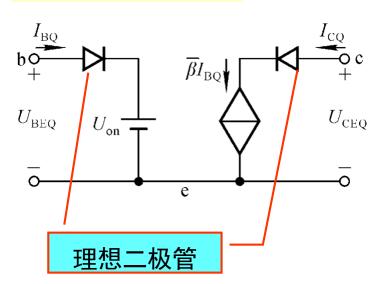


✓ 利用估算法求解静态工作 点,实质上利用了直流模型



输入回路等效为 恒压源

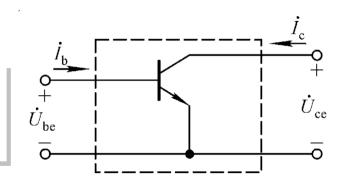
输出回路等效为电 流控制的电流源

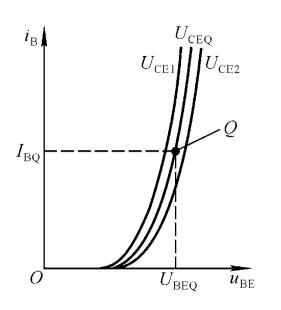


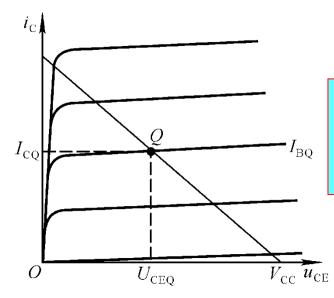


### > 2. 晶体管的h参数等效模型(交流等效模型)

- ✓低频小信号模型
- ✓ 在交流通路中可将晶体管看成为一个
- 二端口网络:输入回路、输出回路端口







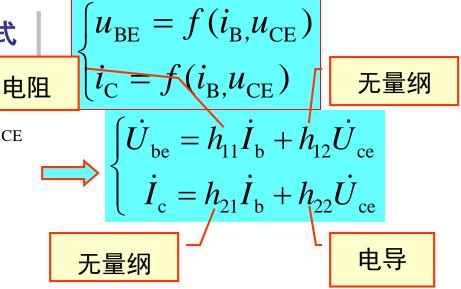
$$\begin{cases} u_{\text{BE}} = f(i_{\text{B}}, u_{\text{CE}}) \\ i_{\text{C}} = f(i_{\text{B}}, u_{\text{CE}}) \end{cases}$$



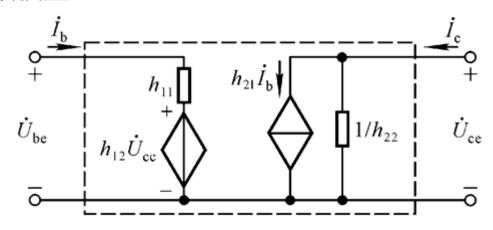
### > 2. 晶体管的h参数等效模型(交流等效模型)

✓在低频、小信号作用下的关系式

$$\begin{cases} du_{BE} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_{B}} \Big|_{U_{CE}} di_{B} + \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \Big|_{I_{B}} du_{CE} \\ di_{C} = \frac{\partial i_{C}}{\partial i_{B}} \Big|_{U_{CE}} di_{B} + \frac{\partial i_{C}}{\partial u_{CE}} \Big|_{I_{B}} du_{CE} \end{cases}$$

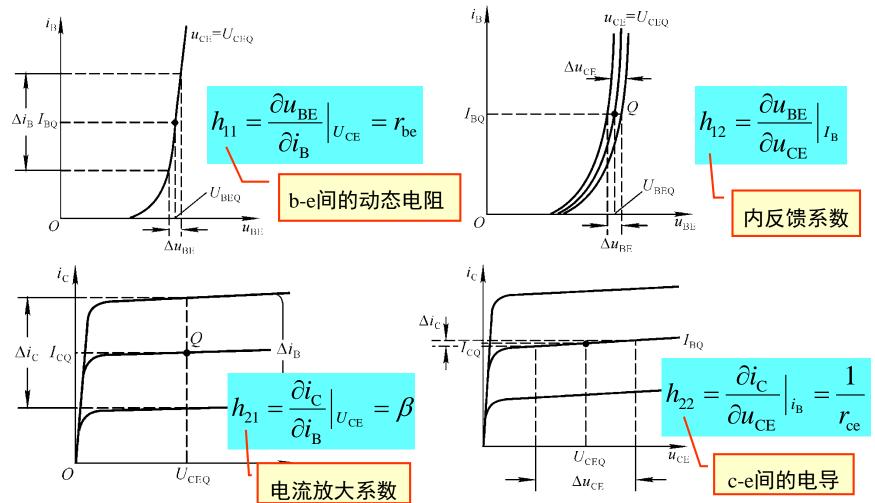


✓ 交流等效模型





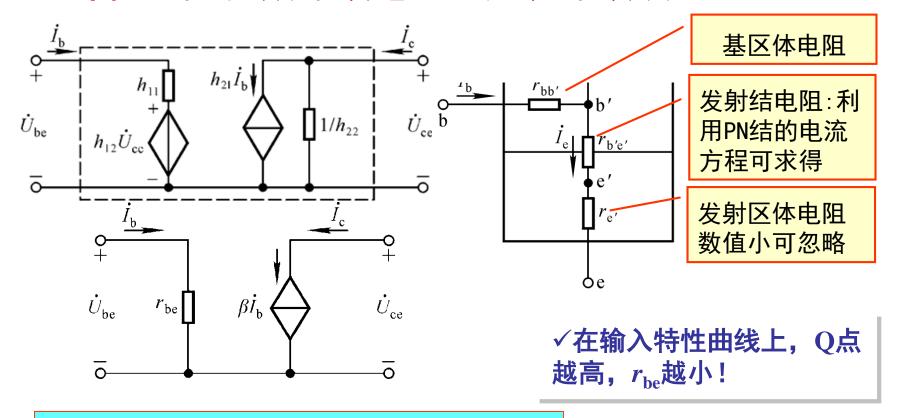
### > h参数的物理意义



✓分清主次,合理近似!什么情况下 $h_{12}$ 和 $h_{22}$ 的作用可忽略不计?



### ▶ 简化的h参数等效电路一交流等效模型



$$r_{\text{be}} = \frac{U_{\text{be}}}{I_{\text{b}}} = r_{\text{bb'}} + r_{\text{b'e}} \approx r_{\text{bb'}} + (1+\beta) \frac{U_{\text{T}}}{I_{\text{EQ}}}$$

- ✓ 适用中低频信号输入场合
- ✓ 适用NPN & PNP型管

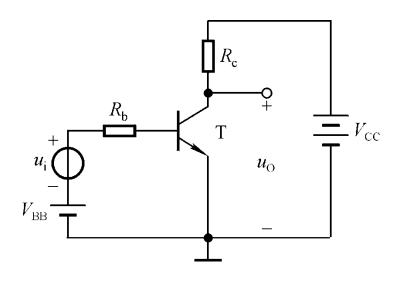
查阅手册

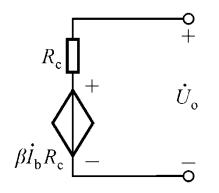
由IEQ算出



### > 3. 放大电路的动态分析

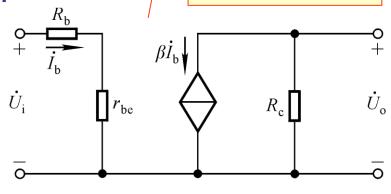
□直接耦合共射放大电路





$$R_{\rm o} = R_{\rm c}$$

放大电路的交流 等效电路



$$\dot{U}_{i} = \dot{I}_{i}(R_{b} + r_{be}) = \dot{I}_{b}(R_{b} + r_{be})$$

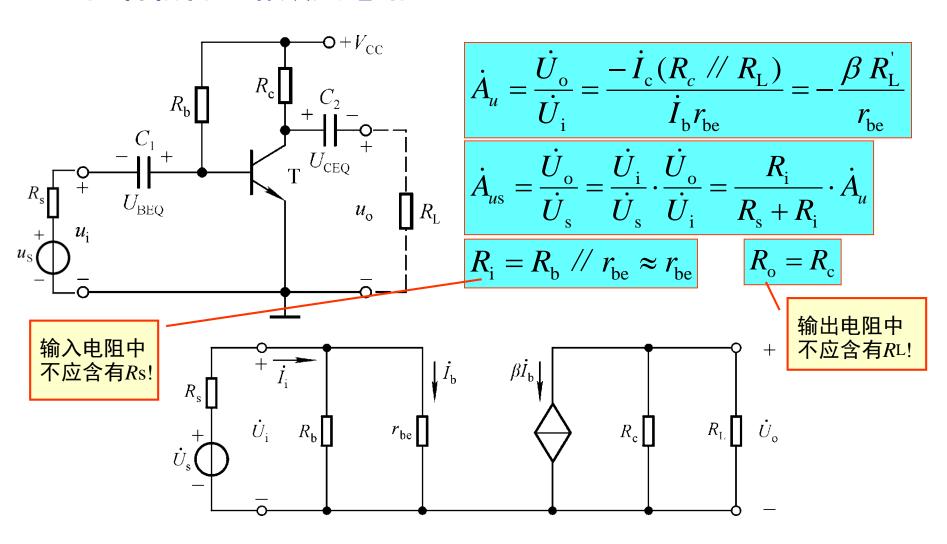
$$\dot{U}_{\rm o} = -\dot{I}_{\rm c}R_{\rm c}$$

$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = -\frac{\beta R_{c}}{R_{b} + r_{be}}$$

$$R_{\rm i} = \frac{U_{\rm i}}{I_{\rm i}} = R_{\rm b} + r_{\rm be}$$



#### □ 阻容耦合共射放大电路

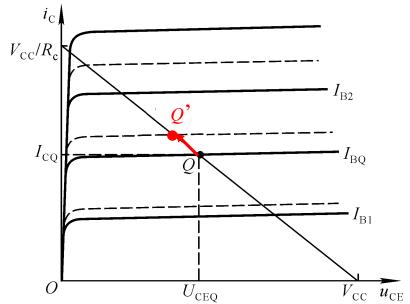




- 一. 温度对静态工作点的影响
- 二. 静态工作点稳定的典型电路
- 三. 稳定静态工作点的方法



### 一、温度对静态工作点的影响



$$T ( {}^{\circ}C ) \rightarrow \beta \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow \rightarrow Q'$$

$$\downarrow I_{CFO} \uparrow \nearrow$$

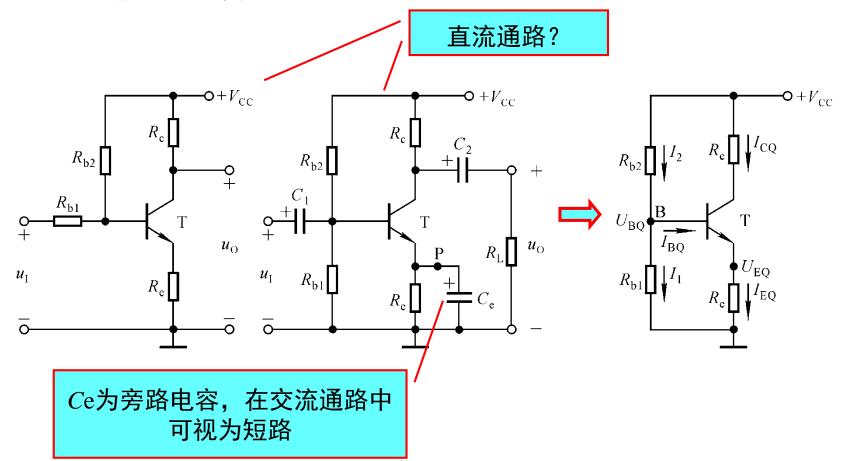
若温度升高时要Q'回到Q,则只有减小 $I_{BO}$ 。

 $\checkmark$ 所谓Q点稳定,是指 $I_{CQ}$ 和 $U_{CEQ}$ 在温度变化时基本不变,这是靠 $I_{BO}$ 的变化得来的。

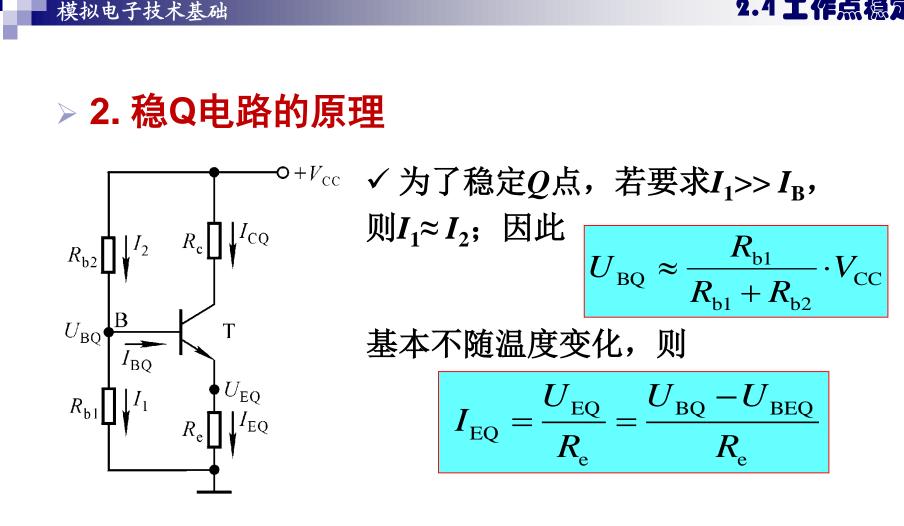


### 二、静态工作点稳定的典型电路

### ▶ 1. 电路组成







$$U_{\rm BQ} \approx \frac{R_{\rm b1}}{R_{\rm b1} + R_{\rm b2}} \cdot V_{\rm CC}$$

$$I_{\mathrm{EQ}} = \frac{U_{\mathrm{EQ}}}{R_{\mathrm{e}}} = \frac{U_{\mathrm{BQ}} - U_{\mathrm{BEQ}}}{R_{\mathrm{e}}}$$

 $T(^{\circ}C) \uparrow \to I_{C} \uparrow \to U_{E} \uparrow \to U_{BE} \downarrow (U_{B}$ 基本不变)  $\to I_{B} \downarrow \to I_{C} \downarrow$ 



### $> R_e$ 的直流负反馈作用

#### $T(^{\circ}C) \uparrow \to I_{C} \uparrow \to U_{E} \uparrow \to U_{BE} \downarrow (U_{B}$ 基本不变) $\to I_{B} \downarrow \to I_{C} \downarrow$

关于反馈的一些概念:  $I_{c}$ 通过 $R_{e}$ 转换为 $\Delta U_{E}$ 影响 $U_{BE}$ 

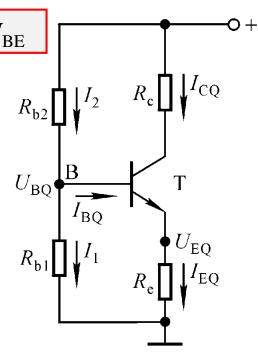
将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入量的措施称为反馈

直流通路中的反馈称为直流反馈

反馈的结果使输出量的变化减小的称

为负反馈, 反之称为正反馈

温度升高I。增大,反馈的结果使之减小



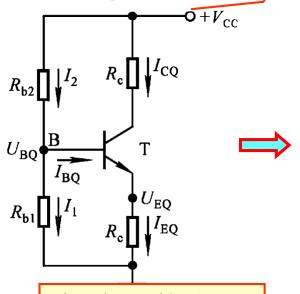
R。起直流负反馈作用,其值越大,反馈越强,Q点越稳定

 $R_{\rm e}$ 有上限值么?

有差调节!



### > 3. Q点分析

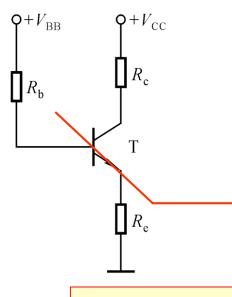


忽略了什么? 何时忽略?

$$U_{\text{BQ}} \approx \frac{R_{\text{b1}}}{R_{\text{b1}} + R_{\text{b2}}} \cdot V_{\text{CC}}$$

$$I_{\text{EQ}} = \frac{U_{\text{BQ}} - U_{\text{BEQ}}}{R_{\text{e}}}$$

#### 分压式电流负反馈工作点稳定电路



$$V_{\rm BB} = \frac{R_{\rm b1}}{R_{\rm b1} + R_{\rm b2}} \cdot V_{\rm CC}$$
  
 $R_{\rm b} = R_{\rm b1} \; / \! / \; R_{\rm b2}$ 

R<sub>b</sub>上静态电压是 否可忽略不计?

$$V_{\rm BB} = I_{\rm BQ}R_{\rm b} + U_{\rm BEQ} + (1+\beta)I_{\rm BQ}R_{\rm e}$$

判断方法:  $R_{b1} // R_{b2} << (1+\beta)R_{e}$ ?

$$I_{\rm BQ} = \frac{I_{\rm EQ}}{1 + \beta}$$

$$U_{\text{CEQ}} = V_{\text{CC}} + I_{\text{CQ}} R_{\text{c}} - I_{\text{EQ}} R_{\text{e}}$$

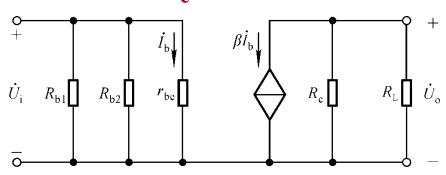
$$\approx V_{\text{CC}} - I_{\text{EQ}} (R_{\text{c}} + R_{\text{e}})$$

要多小?



#### 4. 动态分析

### 有旁路电容 $C_e$ 时:

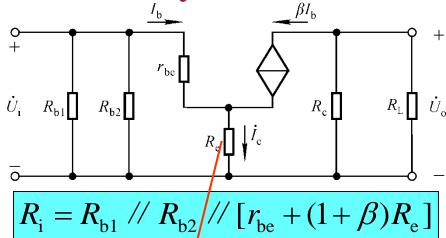


$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = -\frac{\beta R_{L}^{'}}{r_{be}}$$

$$R_{\text{L}} \stackrel{\circ}{\square} \dot{U}_{\circ} R_{\text{i}} = R_{\text{b}1} / R_{\text{b}2} / R_{\text{b}e}$$

$$R_{\rm o} = R_{\rm c}$$

#### 无旁路电容 $C_{\mathfrak{o}}$ 时:



$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}}$$

$$= \frac{-\beta \dot{I}_{b} (R_{c} // R_{L})}{\dot{I}_{b} r_{be} + \dot{I}_{e} R_{e}}$$

$$= -\frac{\beta R_{L}'}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e}}$$

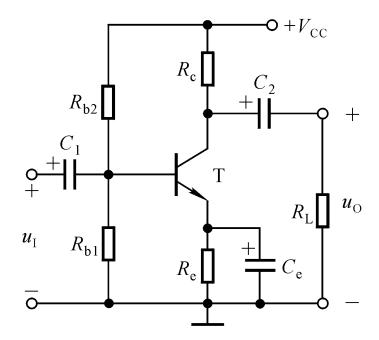
#### 利?弊?

若
$$(1+\beta)R_{\rm e} >> r_{\rm be}$$
,则 $\dot{A}_{\rm u} \approx -\frac{R_{\rm L}}{R_{\rm e}}$ 



### 三、稳定静态工作点的方法

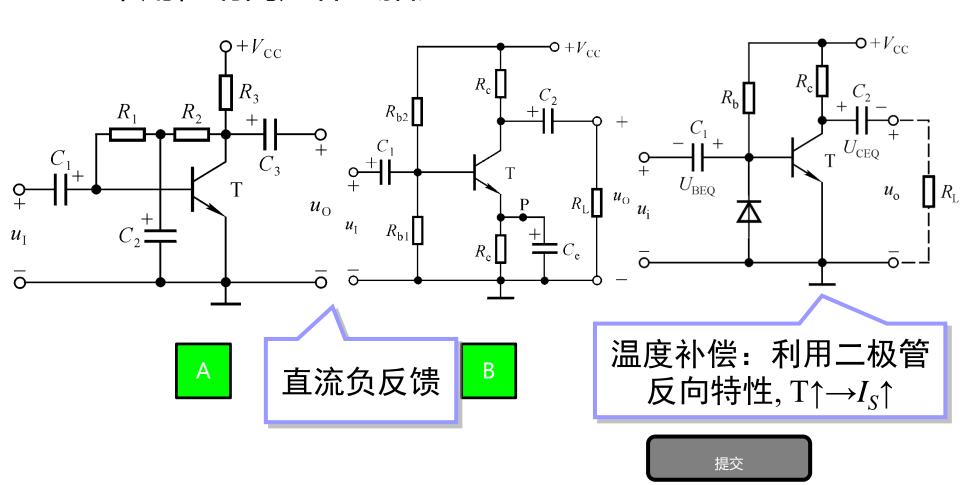
- □引入直流负反馈
- □ 温度补偿:利用对温度敏感的元件,在温度变化时直接影响输入回路
- 回例如, $R_{b1}$ 或 $R_{b2}$ 采用热敏电阻,它们的温度系数?



$$T(^{\circ}C) \uparrow \rightarrow I_{C} \uparrow \rightarrow U_{E} \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_{B} \downarrow \rightarrow I_{C} \downarrow$$

$$R_{b1} \downarrow \rightarrow U_{B} \downarrow \nearrow$$

# 图示哪些电路采用了措施来稳定静态工作点?若采用,请问是什么措施?



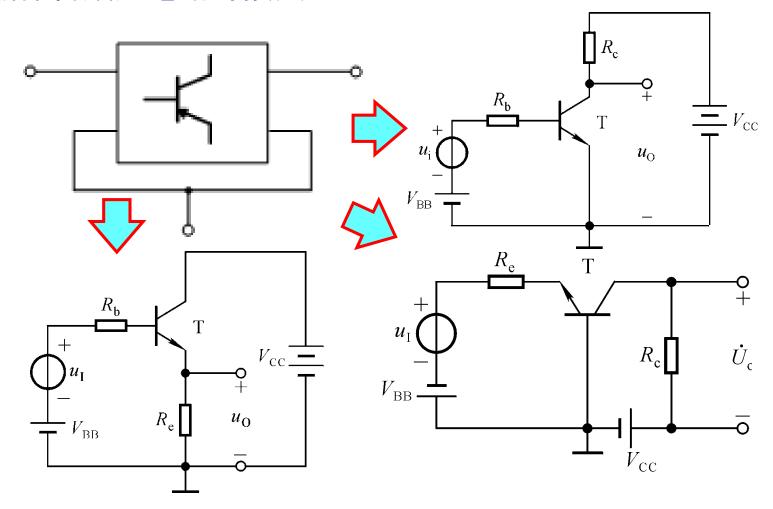


- 一. 基本共射放大电路
- 二. 基本共集放大电路
- 三. 基本共基放大电路
- 四. 三种接法放大电路的比较



### 讨论

□ 晶体管放大电路的接法?





### 晶体管放大电路的三种基本接法: 共射 共集 共基

- 口 共射(CE, Common-emitter): 以e为输入回路和输出回路的公共端,用来实现 $i_B$ 对 $i_C$ 的控制。
- □ 共集(CC, Common-collector): 以c为公共端的接法用来实现 $i_R$ 对 $i_E$ 的控制
- 口 共基(CB, Common-base): 以b为公共端的接法,用来实现 $i_E$ 对 $i_C$ (或 $i_C$ 对 $i_E$ )的控制。

✓注意:三种接法都是从交流通路中定义的, 即,输入回路和输出回路是指交流通路中的



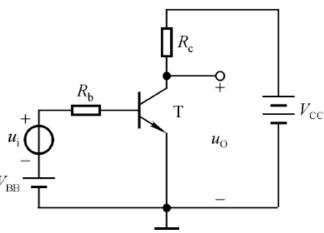
### 一、基本共射放大电路

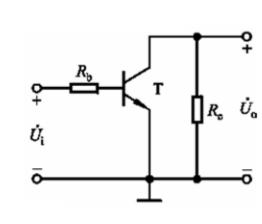
□ 静态Q点: 直流通路

$$I_{\text{BQ}} = \frac{V_{\text{BB}} - U_{\text{BEQ}}}{R_{\text{b}}}$$

$$I_{\text{CQ}} = \beta I_{\text{BQ}} \approx I_{\text{EQ}}$$

$$oldsymbol{U}_{ ext{CEQ}} = oldsymbol{V}_{ ext{CC}} - oldsymbol{I}_{ ext{CQ}} oldsymbol{R}_{ ext{c}} \hspace{0.1cm} V_{ ext{BB}}$$

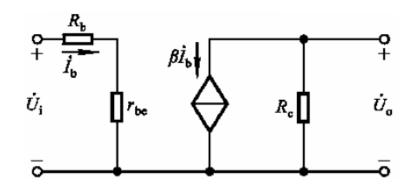




□ 动态: 求 $A_{\mu}$ 、 $R_{i}$ 、R。

$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{-\dot{I}_{c} R_{c}}{\dot{I}_{b} (R_{b} + r_{be})} = \frac{-\beta R_{c}}{R_{b} + r_{be}}$$

$$R_{\rm i} = \dot{U}_{\rm i} / \dot{I}_{\rm b} = R_{\rm b} + r_{\rm be} \qquad R_{\rm o} = R_{\rm c}$$



#### □特点:

✓ 既能放大电压,又能放大电流

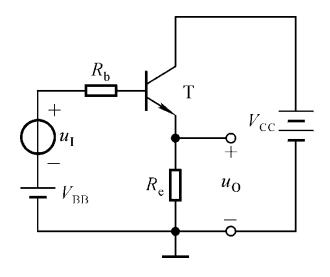
 $\checkmark U_o 与 U_i 反相$ 





### 二、基本共集放大电路

#### ▶ 1.静态分析



#### □输入回路

$$V_{\mathrm{BB}} = I_{\mathrm{BQ}} R_{\mathrm{b}} + U_{\mathrm{BEQ}} + I_{\mathrm{EQ}} R_{\mathrm{e}}$$

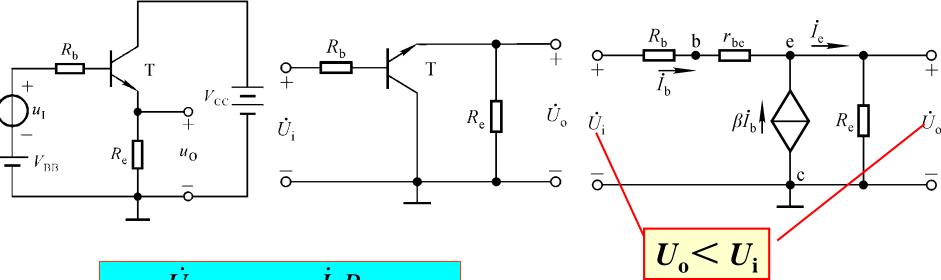
$$I_{\text{BQ}} = \frac{V_{\text{BB}} - U_{\text{BEQ}}}{R_{\text{b}} + (1 + \beta)R_{\text{e}}}$$

#### □输出回路

$$I_{\text{EQ}} = (1 + \beta)I_{\text{BQ}}$$
$$U_{\text{CEQ}} = V_{\text{CC}} - I_{\text{EQ}}R_{\text{e}}$$



### ▶ 2. 动态分析: 电压放大倍数



$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{\dot{I}_{e}R_{e}}{\dot{I}_{b}(R_{b} + r_{be}) + \dot{I}_{e}R_{e}}$$

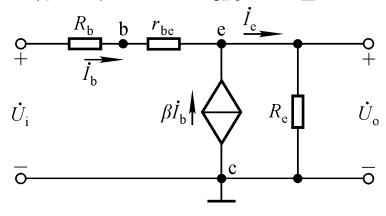
$$= \frac{(1+\beta)R_{e}}{R_{b} + r_{be} + (1+\beta)R_{e}}$$

故称之为射 极跟随器

若  $(1+\beta)$   $R_{\rm e} >> R_{\rm b} + r_{\rm be}$ , 则  $\dot{A}_{\rm u} \approx 1$ , 即  $U_{\rm o} \approx U_{\rm i}$ 



### > 2. 动态分析: 输入电阻



$$R_{\rm i} = \frac{U_{\rm i}}{I_{\rm i}} = \frac{U_{\rm i}}{I_{\rm b}} = R_{\rm b} + r_{\rm be} + (1+\beta)R_{\rm e}$$

从基极看 $R_{\rm e}$ ,被增 大到(1+β)倍

> R大:几十千 ~几百千欧

带负载电阻后 
$$R_{\rm i} = R_{\rm b} + r_{\rm be} + (1+\beta)(R_{\rm e} // R_{\rm L})$$

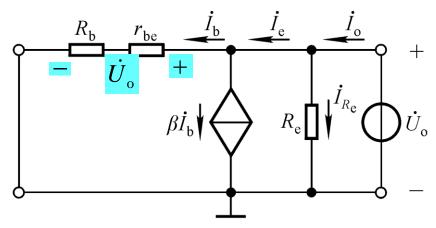
 $R_i$ 与负载有关! 受后级电路影响



加压求流法!

### > 2. 动态分析: 输出电阻

令 $U_{\rm s}$ 为零,保留 $R_{\rm s}$ ,在输出端加 $U_{\rm o}$ ,产生 $I_{\rm o}$ , $R_{\rm o}=U_{\rm o}/I_{\rm o}$ 。



 $R_0$ 与信号源内阻有关!

从射极看基极回路电阻,被减 小到(1+β)倍

$$R_{o} = \frac{U_{o}}{I_{o}} = \frac{U_{o}}{I_{R_{e}} + I_{e}}$$

$$= \frac{U_{o}}{\frac{U_{o}}{R_{e}} + (1 + \beta) \frac{U_{o}}{R_{b} + r_{be}}}$$

$$= R_{e} / \frac{R_{b} + r_{be}}{1 + \beta}$$

*R*。小:几十 ~几百欧

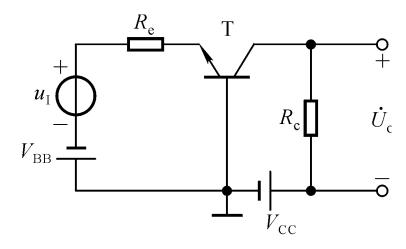


- > 3. 共集放大电路的特点:
  - □ 具有电压跟随作用 $(A_u \approx 1)$ ,  $U_o \vee U_i$ 同相
  - $\square$   $R_i$ 大(几十到几百k $\Omega$ ),从信号源索取的电流小
  - 口  $R_o$ 小(几十到几百 $\Omega$ ),带负载能力强
  - □ 只放大电流,不放大电压
  - □ 一般作为输入级、输出级或者中间缓冲电路



### 三、基本共基放大电路

### ▶ 1. 静态分析



#### □输入回路

$$U_{\mathrm{BEQ}} + I_{\mathrm{EQ}} R_{\mathrm{e}} = V_{\mathrm{BB}}$$

□输出回路

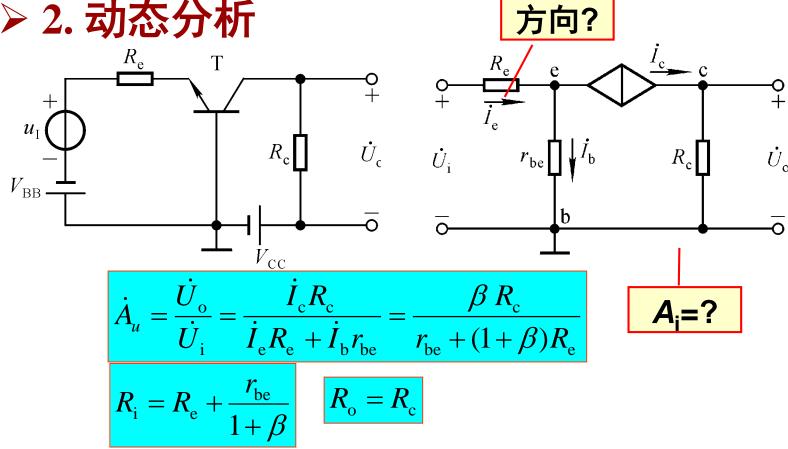
$$I_{\text{CO}}R_{\text{c}} + U_{\text{CEO}} - U_{\text{BEO}} = V_{\text{CC}}$$

$$I_{\text{EQ}} = \frac{V_{\text{BB}} - U_{\text{BEQ}}}{R_{\text{e}}}$$
  $I_{\text{BQ}} = \frac{I_{\text{EQ}}}{1 + \beta}$ 

$$U_{\rm CEQ} = V_{\rm CC} - I_{\rm EQ} R_{\rm c} + U_{\rm BEQ}$$



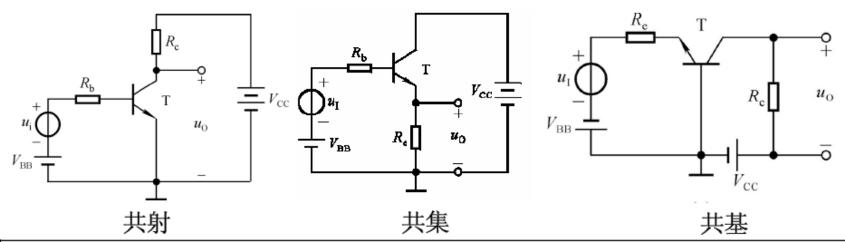




- ▶ 3. 特点 □ 输入电阻小,频带宽,用于宽频带放大电路;
  - □ 只放大电压,不放大电流!



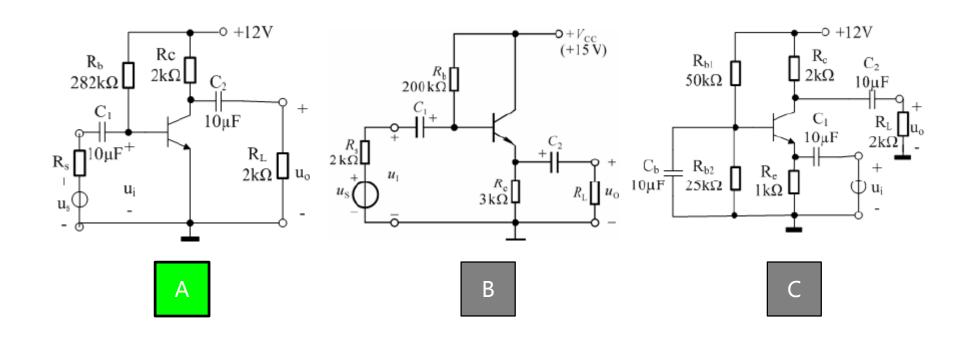
## 四、三种接法的比较:空载情况下



基本接法	CE	CC	СВ
$ A_{u} $	大( $U_{o}$ 与 $U_{i}$ 反相)	<1(U <sub>o</sub> 与U <sub>i</sub> 同相)	中( $U_{o}$ 与 $U_{i}$ 同相)
$A_i$	$oldsymbol{eta}$	1+eta	$\alpha = \beta/(1+\beta) < 1$
$R_{\rm i}$	中	大	<b>/</b>  \
$R_{\rm o}$	$R_{\rm c}$	小	$R_{\rm c}$
$f_{ m w}$	窄	中	宽
主要用途	用于低频电压放力	、 输入级和输出级	宽频带放大电路

#### ② 设置

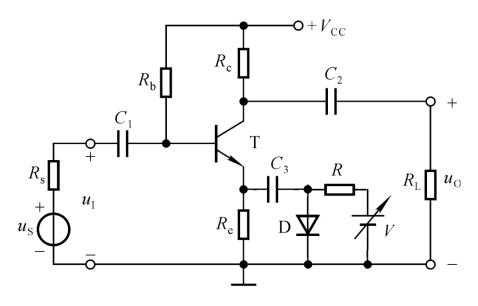
### 以下放大电路中, 共射接法的电路为?





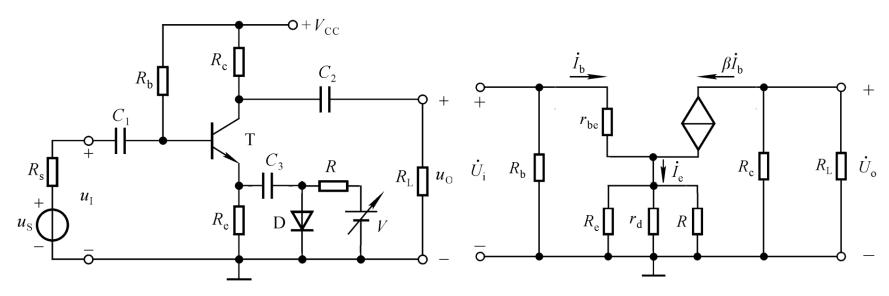
### ≻讨论2

□ 电路如图, 所有电容对交流信号均可视为短路。



- 1. Q为多少?
- 2.  $R_e$ 有稳定Q点的作用吗?
- 3. 电路的交流等效电路?
- 4. V 变化时, 电压放大倍数如何变化?





$$\dot{A}_{u} = -\frac{\beta (R_{c} // R_{L})}{r_{be} + (1 + \beta)(R_{e} // r_{D} // R)}$$

当
$$R_{\rm e}$$
 //  $R > > r_{\rm D}$ 时,
$$\dot{A}_{\rm u} \approx -\frac{\beta(R_{\rm c} // R_{\rm L})}{r_{\rm be} + (1+\beta)r_{\rm D}}, \quad V \uparrow \to r_{\rm D} \downarrow \to \left| \dot{A}_{\rm u} \right| \uparrow$$



- 一.场效应管
- 二. 场效应管放大电路静态工作点 的设置方法
- 三. 场效应管放大电路的动态分析



### 一、场效应管

#### ▶特点:

- □ 输入电阻高(MΩ以上)
- □制作体积小,集成工艺简单,广泛应用于大规模和超 大规模集成电路
- □噪声低,热稳定性好,抗辐射能力强
- □ 耗电少, 工作电压范围宽

#### > 分类:

- □ 结型 (JFET, Junction field effect transistor)
- □ 绝缘栅型 (MOSFET, Mental Oxide Semiconductor FET)

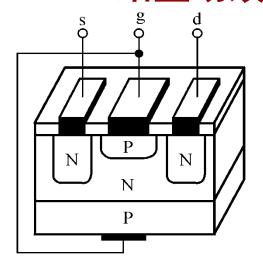


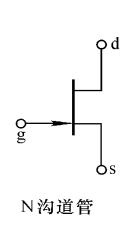
### 一、场效应管(以N沟道为例)

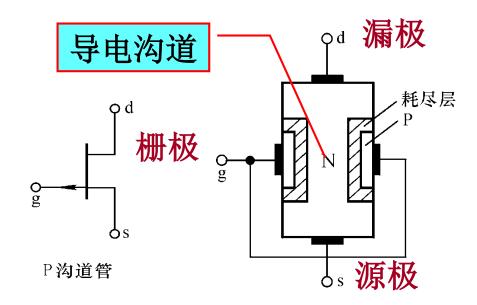
#### > 单极型管

- □ 三个极: 源极 (s), 栅极 (g), 漏极 (d), 对应晶体管的e, b, c
- □ 三个工作区:截止区、恒流区、可变电阻区,对应晶体管的截止区、放大区、饱和区

#### ▶ 1. 结型场效应管

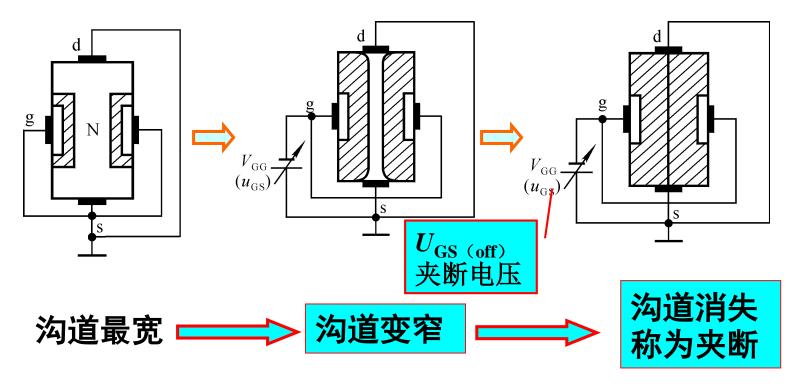








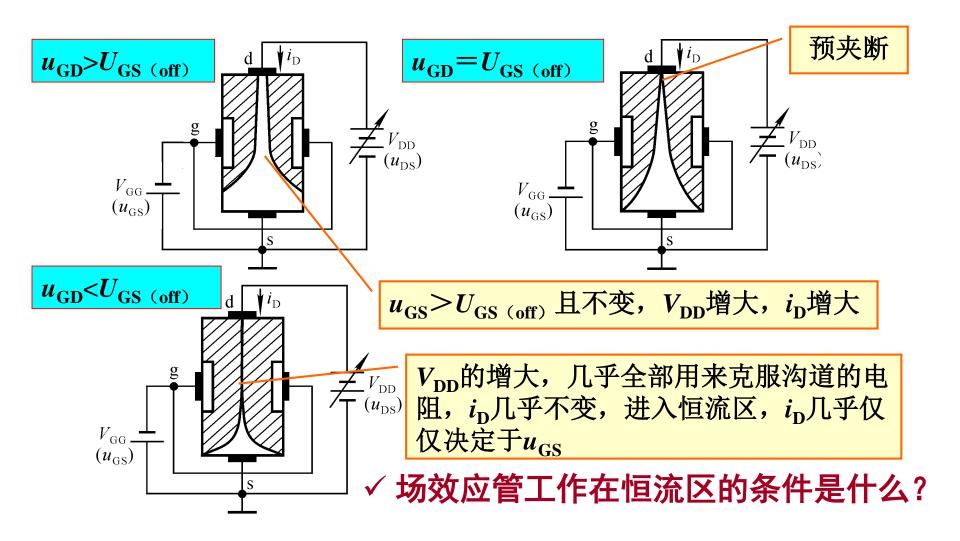
### > 栅-源电压对导电沟道宽度的控制作用



- ✓ u<sub>GS</sub>可以控制导电沟道的宽度
- ✓为什么g-s必须加负电压?
- ✓为什么结型场效应管输入电阻大?



#### >漏-源电压对漏极电流的影响

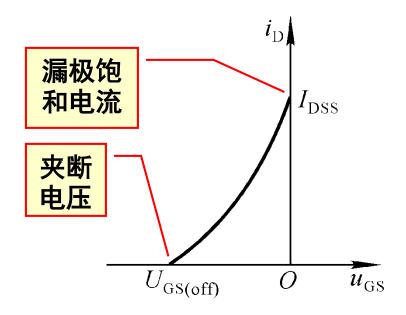


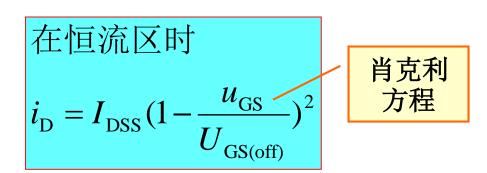


#### > 转移特性

$$\left| i_{\mathrm{D}} = f(u_{\mathrm{GS}}) \right|_{U_{\mathrm{DS}} = \hat{\pi} \equiv 0}$$

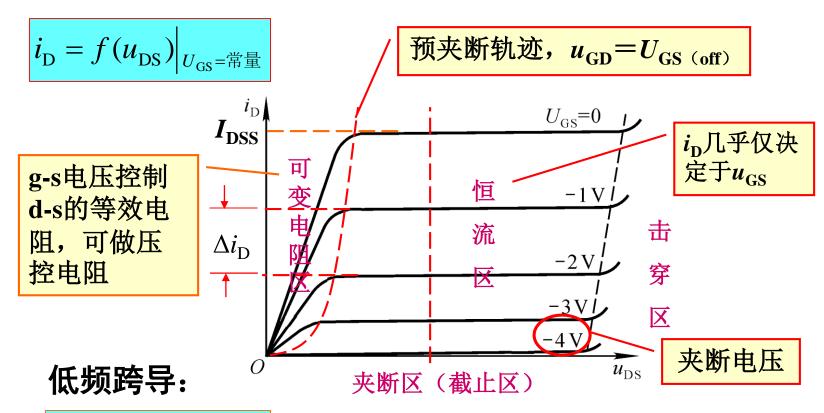
场效应管工作在恒流区,因而 $u_{GS} \ge U_{GS \text{ (off)}} \perp u_{GD} < U_{GS \text{ (off)}}$ 







#### ➤ 输出特性



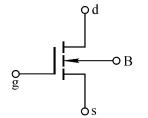
$$g_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta i_{\mathrm{D}}}{\Delta u_{\mathrm{GS}}} \Big|_{U_{\mathrm{DS}} = \text{ml}}$$

不同型号的管子 $U_{GS \text{ (off)}}$ 、 $I_{DSS}$ 将不同,同型号的管子也有分散性!



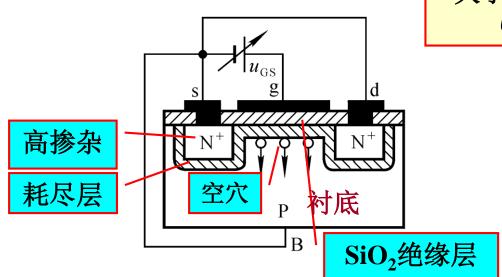
# 二、绝缘栅型场效应管

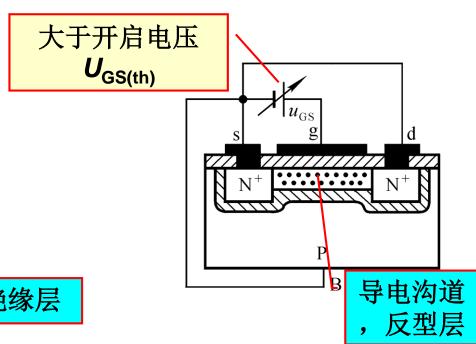
增强型MOS管



#### ▶1、增强型MOS管





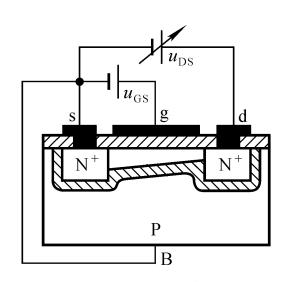


 $u_{GS}$ 增大,反型层(导电沟道)将变厚变长。当反型层 将两个N区相接时,形成导电沟道

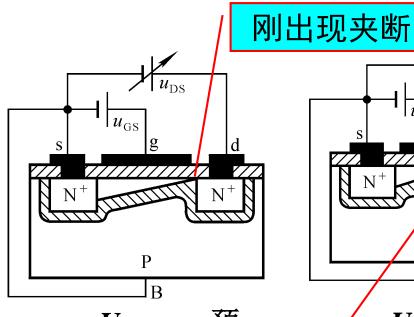
- ✓ 为何增强型MOS管输入电阻大?
- ✓ 导电沟道形成的条件是什么?



# $\square u_{DS}$ 对 $i_D$ 的影响



 $i_{\rm D}$ 随 $u_{\rm DS}$ 的增大而增大,可变电阻区



 $u_{\mathrm{GD}} = U_{\mathrm{GS}\ (\mathrm{th})}$ ,预夹断

 $u_{
m GD}$ < $U_{
m GS~(th)}$ , $i_{
m D}$ 几乎仅仅受控于  $u_{
m GS}$ ,恒流区

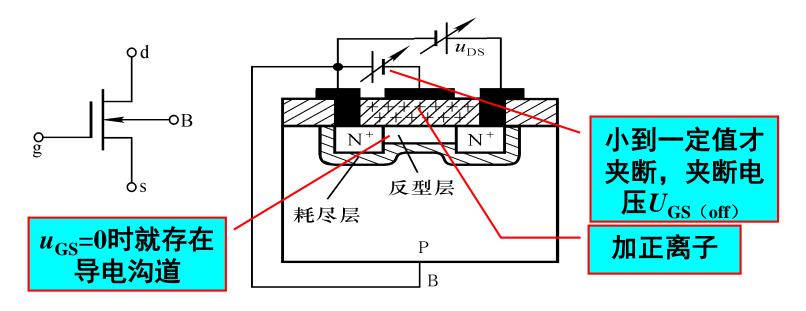
u<sub>GS</sub>的增大几乎全部用 来克服夹断区的电阻

用场效应管组成放大电路时应使之工作在恒流区

✓N沟道增强型MOS管工作在恒流区的条件是什么?



#### ▶2、耗尽型 MOS管

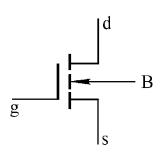


耗尽型MOS管在  $u_{GS}>0$ 、  $u_{GS}<0$ 、  $u_{GS}=0$ 时均可导通,且与结型场效应管不同,由于SiO<sub>2</sub>绝缘层的存在,在  $u_{GS}>0$ 时仍保持g-s间电阻非常大的特点

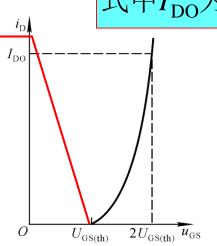


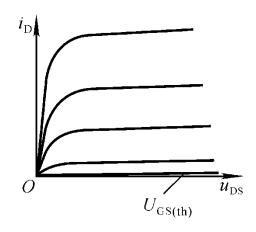
1)增强型MOS管

在恒流区时, $i_{\rm D} = I_{\rm DO} (\frac{u_{\rm GS}}{U_{\rm GS(th)}} - 1)^2$ 式中 $I_{\rm DO}$ 为 $u_{\rm GS} = 2U_{\rm GS(th)}$ 时的 $i_{\rm D}$ 

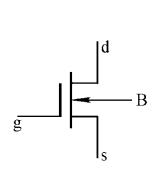


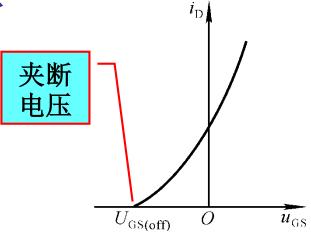
开启 电压

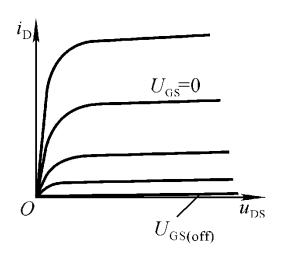




2)耗尽型MOS管









#### > 3. 场效应管的分类

## 工作在恒流区时g-s、d-s间的电压极性

## $u_{GS}=0$ 可工作在恒流区的场效应管有哪几种?

- A N沟道结型
- B P沟道结型
- N沟道增强绝缘栅型
- P沟道增强绝缘栅型
- F N沟道耗尽绝缘栅型
- FP沟道耗尽绝缘栅型

# u<sub>GS</sub>>0可工作在恒流区的场效应管有哪几种?

- AN沟道结型
- B P沟道结型
- N沟道增强绝缘栅型
- □ P沟道增强绝缘栅型
- F N沟道耗尽绝缘栅型
- F沟道耗尽绝缘栅型

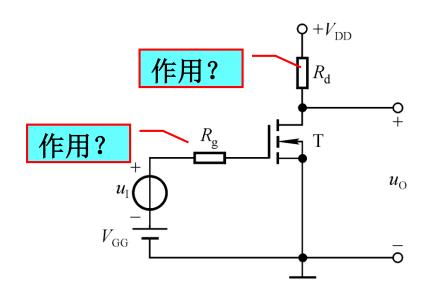
# u<sub>GS</sub><0可工作在恒流区的场效应管有哪几种?

- A N沟道结型
- B P沟道结型
- c N沟道增强绝缘栅型
- P沟道增强绝缘栅型
- F N沟道耗尽绝缘栅型
- FP沟道耗尽绝缘栅型



# 二、场效应管静态工作点的设置方法

- > 1. 基本共源放大电路
- □ 根据场效应管工作在恒流区的条件,在g-s、d-s间加极性合适的电源

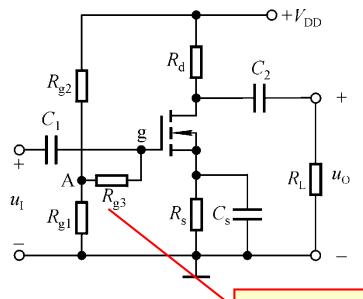


$$\begin{split} &U_{\rm GSQ} = V_{\rm GG} \\ &I_{\rm DQ} = I_{\rm DO} (\frac{V_{\rm GG}}{U_{\rm GS(th)}} - 1)^2 \\ &U_{\rm DSQ} = V_{\rm DD} - I_{\rm DQ} R_{\rm d} \end{split}$$



# 二、场效应管静态工作点的设置方法

- ▶ 2. 分压式偏置电路
- □即典型的Q点稳定电路



$$\begin{split} \boldsymbol{U}_{\mathrm{GQ}} &= \boldsymbol{U}_{\mathrm{AQ}} = \frac{R_{\mathrm{g1}}}{R_{\mathrm{g1}} + R_{\mathrm{g2}}} \cdot \boldsymbol{V}_{\mathrm{DD}} \\ \boldsymbol{U}_{\mathrm{SQ}} &= \boldsymbol{I}_{\mathrm{DQ}} \boldsymbol{R}_{\mathrm{s}} \end{split}$$

$$I_{\mathrm{DQ}} = I_{\mathrm{DO}} \left(\frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}} - 1\right)^{2}$$

$$U_{\rm DSQ} = V_{\rm DD} - I_{\rm DQ} (R_{\rm d} + R_{\rm s})$$

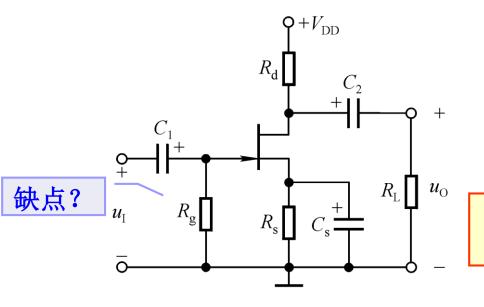
为什么加 $R_{g3}$ ?其数值应大些小些?

 $\checkmark$ 哪种场效应管能够采用这种电路形式设置Q点?



# 二、场效应管静态工作点的设置方法

#### ▶ 3. 自给偏压电路



$$U_{\rm GQ}=0$$
,  $U_{\rm SQ}=I_{\rm DQ}R_{\rm s}$  
$$U_{\rm GSQ}=U_{\rm GQ}-U_{\rm SQ}=-I_{\rm DQ}R_{\rm s}$$

由正电源获得负偏压 称为自给偏压

$$I_{\rm DQ} = I_{\rm DSS} (1 - \frac{U_{\rm GSQ}}{U_{\rm GS(off)}})^2$$

$$U_{\rm DSQ} = V_{\rm DD} - I_{\rm DQ} (R_{\rm d} + R_{\rm s})$$

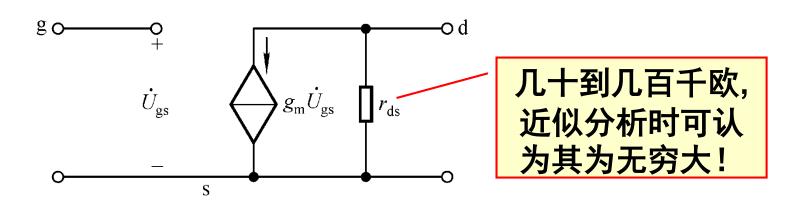
 $\checkmark$ 哪种场效应管能够采用这种电路形式设置Q点?



# 三、场效应管放大电路的动态分析

#### > 1. 场效应管的交流等效模型

与晶体管的h参数等效模型类比:

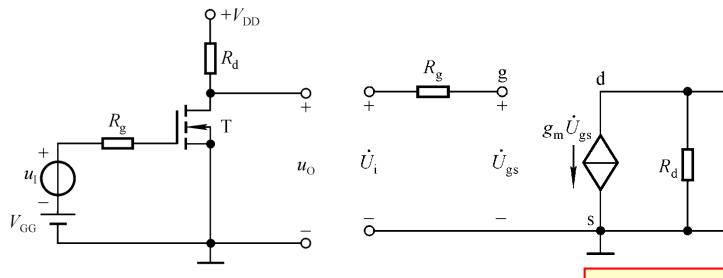


$$g_{\rm m} = \frac{\partial i_{\rm D}}{\partial u_{\rm GS}} \Big|_{U_{\rm DS}}$$

根据 $i_D$ 的表达式或转移特性可求得 $g_m$ 

# 场效应管放大电路的动态分析

### > 2. 基本共源放大电路的动态分析



$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{-\dot{I}_{d}R_{d}}{\dot{U}_{gs}} = -g_{m}R_{d}$$

$$R_{\rm i} = \infty$$

$$R_{\rm o} = R_{\rm d}$$

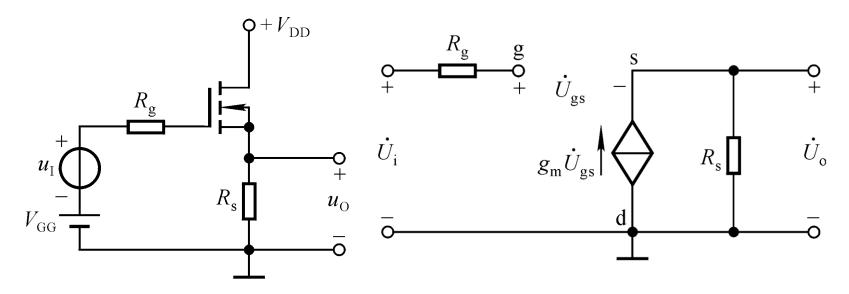
## 如何增大A..?

 $k_{\rm d} = 3kΩ$ ,  $R_{\rm g} = 5kΩ$ ,  $g_{\mathbf{m}}=2\mathbf{mS}$ ,则  $\dot{A}_{\mu}=?$ 与共射电路比较?



# 三、场效应管放大电路的动态分析

### > 3. 基本共漏放大电路的动态分析



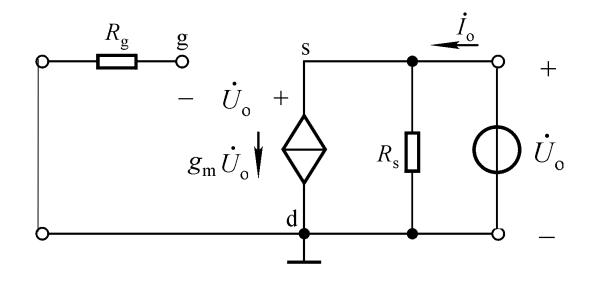
$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{\dot{I}_{d}R_{s}}{\dot{U}_{gs} + \dot{I}_{d}R_{s}} = \frac{g_{m}R_{s}}{1 + g_{m}R_{s}}$$

$$R_{i} = \infty$$

若 $R_s$ =3k $\Omega$ , $g_m$ =2mS,则 $\dot{A}_u$ =?



### > 3. 基本共漏放大电路输出电阻的分析



$$R_{\rm o} = \frac{U_{\rm o}}{I_{\rm o}} = \frac{U_{\rm o}}{\frac{U_{\rm o}}{R_{\rm s}} + g_{\rm m}U_{\rm o}} = R_{\rm s} // \frac{1}{g_{\rm m}}$$

若 $R_s$ =3k $\Omega$ , $g_m$ =2mS,则 $R_o$ =?



# § 2.7 复合管

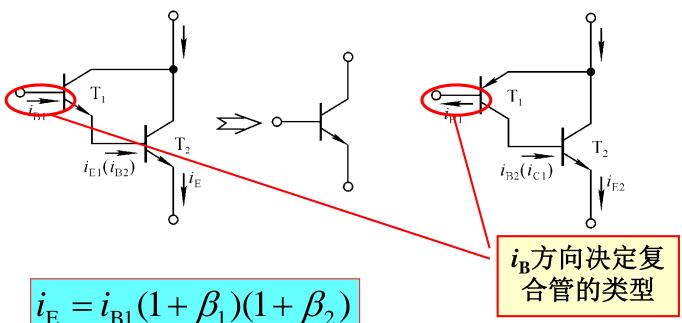
- $\triangleright$  单个晶体管的输入电阻( $r_{be}$ )以及放大倍数常常不能满足放大电路的要求,常采用两个或者多个管子组成复合管,以提高 $R_i$ 和放大倍数
- > 为了利用不同晶体管或场效应管的特点,常采用两个或者多个管子组成复合管,以提高管子的性能

#### > 复合管组成原则:

- □ 保证每个管子工作在放大状态时各极电流方向正确
- □ 保证每个管子工作在放大状态时各极电位关系正确



#### > 复合管的组成: 多只管子合理连接等效成一只管子



$$l_{\rm E} = l_{\rm B1}(1 + \rho_1)(1 + \rho_2)$$

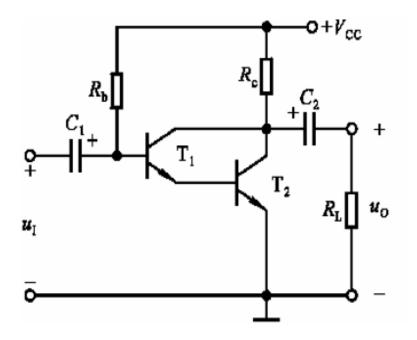
$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

✓ 不同类型的管子复合后, 其类型决定于T₁管。



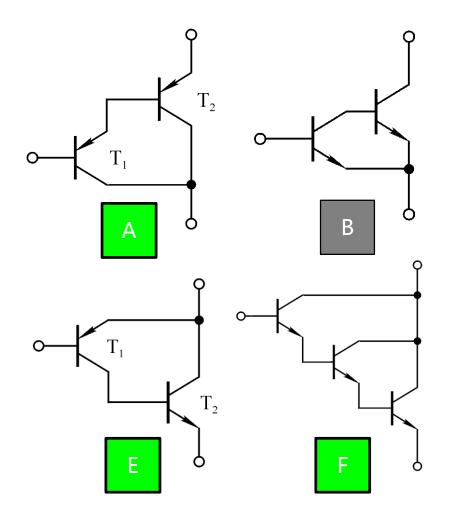
#### > 复合管组成的放大电路

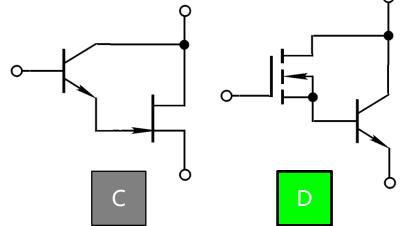
•基本共射放大电路



- $\triangleright$  复合管可视为  $\beta = \beta_1 \beta_2$ ,  $r_{be} = r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}$ 的晶体管
- $\triangleright$  目的: 提高 $R_i$ 、 $\beta$

#### 下列各图能组成复合管的是:





在合适的外加电压下,每 只管子的电流都有合适的 通路,才能组成复合管